

1.5A 双 H 桥马达驱动芯片

特性

- 低待机电流: <1uA
- 宽电源范围: 2~7V
- 集成 PMOS/NMOS 功率管的双 H 桥
 - ✓ 导通电阻(HS+LS) $R_{on}=0.45\Omega @ 800mA$
 - ✓ 双通道同时工作电流: CHA=CHB=1.2A
 - ✓ 单通道工作电流: 1.5A
 - ✓ 单驱动器输出峰值电流: 2.5A
- 内部集成续流二极管
 - ✓ 无需外接续流二极管
- 集成具有热迟滞过热保护
- 输入引脚内置约 $150k\Omega$ 对地下拉电阻
- 宽工作温度范围 -25~85°C
- 封装: SOP-16L

应用

- 玩具直流电机驱动
- 小家电应用

概述

LY2501S 为一款专用于小型电机驱动的驱动芯片。该芯片采用 H 桥电路结构，内置 P/N MOSFET 功率开关，可为电机提供正转、反转、刹车以及待机四种控制模式。芯片集成了双 H 桥驱动器，可驱动两个直流有刷电机或者一个步进电机。

该芯片具有宽工作电压范围，2V~7V。在环境温度为 27°C，VDD=7V 的情况下，该芯片向电机负载提供持续电流高达 1.5A，最大峰值电流(或堵转电流)高达 2.5A。

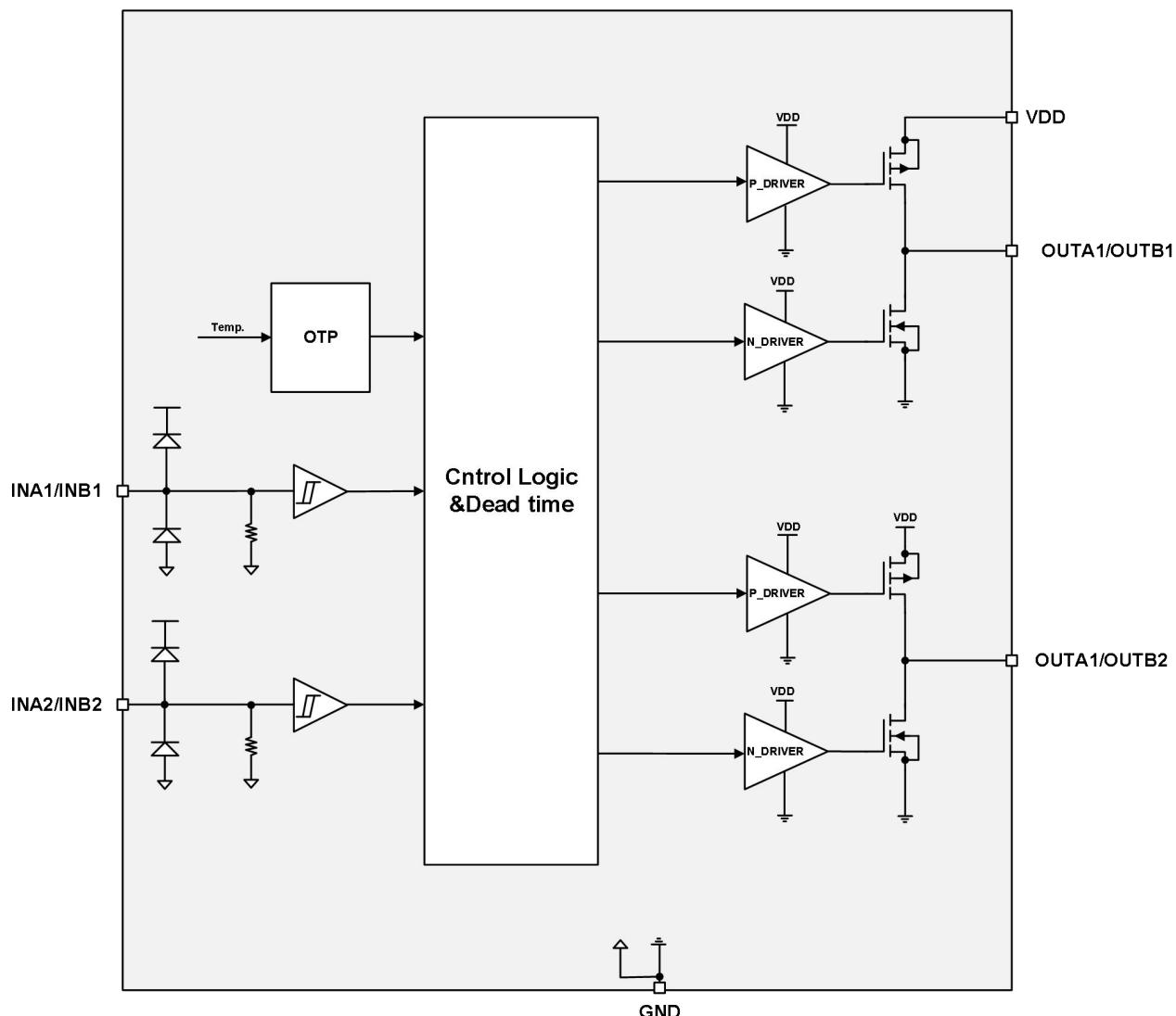
芯片内部集成了感知结温度异常的过温度保护电路，能实时监控芯片结温度是否异常并提供保护。当结温度超过 150°C (典型值) 时，芯片内部电路关闭功率管，停止输出电流，待结温度下降到 130°C 的安全温度后，芯片再重新恢复工作并按照输入对功率管进行开关控制。该过温度保护可避免芯片因过温而烧毁，同时可以避免因温度上升导致的封装塑料冒烟、起火等严重安全事故。

该芯片采用业界标准的 PWM 逻辑输入引脚 INA1/INA2, INB1/INB2。

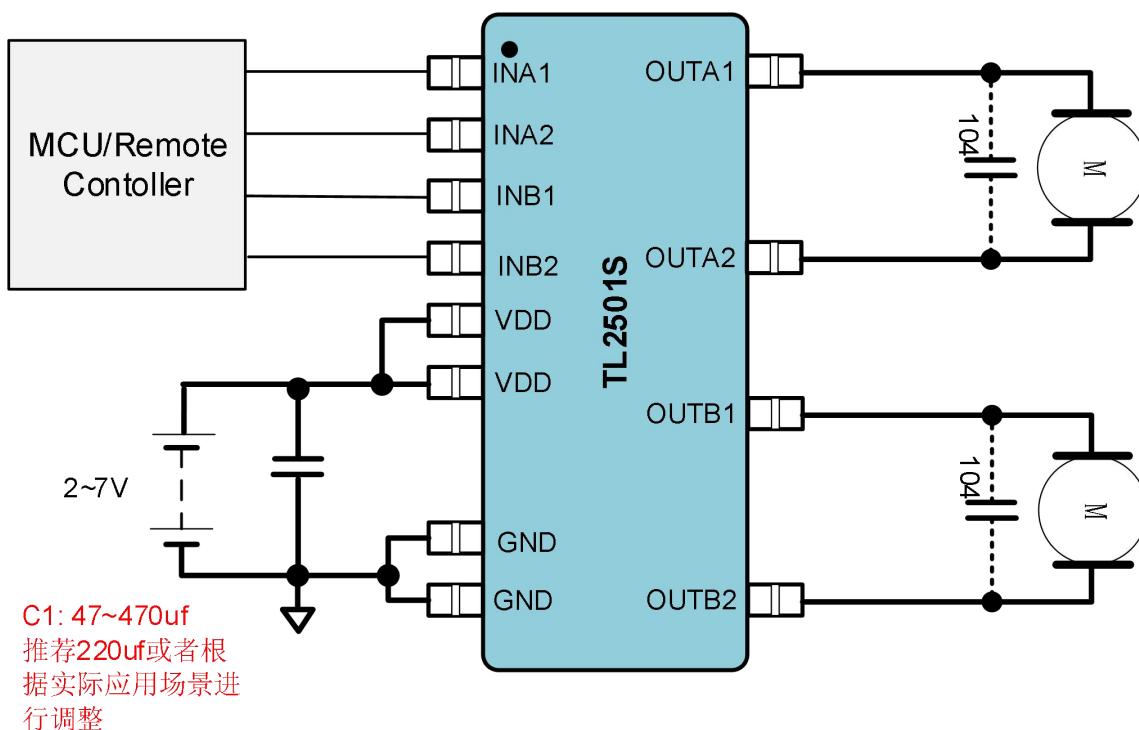
订购信息

产品型号	封装形式	印字	数量/盘	说明
LY2501S	SOP_16L	2501S	4000	

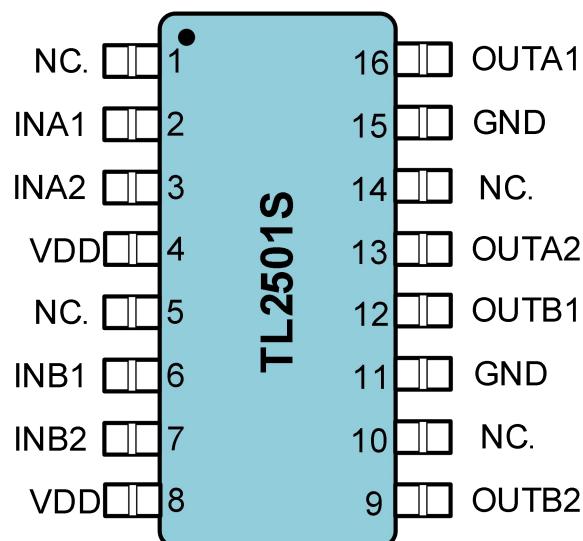
功能方框图



简单应用原理图



管脚信息



SOP-16L

LY2501S 管脚定义 (SOP-16L)

管脚号	管脚名	描述
1	NC.	未连接引脚。
2	INA1	A 通道正转控制信号输入端。
3	INA2	A 通道反转控制信号输入端。
4	VDD	输入电源。
13	OUTA2	A 通道反转驱动输出端。
14	NC.	未连接引脚。
15	GND	芯片功率地。
16	OUTA1	A 通道正转驱动输出端。
5	NC.	未连接引脚。
6	INB1	B 通道正转控制信号输入端。
7	INB2	B 通道反转控制信号输入端。
8	VDD	输入电源。
9	OUTB2	B 通道反转驱动输出端。
10	NC.	未连接引脚。
11	GND	芯片功率地。
12	OUTB1	B 通道正转驱动输出端。

极限参数

参数	最小值	最大值	单位
VDD	-0.3	8	V
OUTA/B1、OUTA/B2	-0.3	VDD+0.3	
INA/B1、INA/B2	-0.3	VDD+0.3	
最大持续输出电流（单通道）	-	1.5	A
最大输出峰值电流	-	3	
存储温度	-55	150	°C
最大功耗	-	1.5	W
封装热阻	Θ_{ja}	80	°C/W
引脚焊接温度 (10S)	-	260	°C

注：任何超出极限参数范围的应力可能会造成芯片的损坏或者存在潜在的损坏。以上仅为芯片的极限参数，但并不表示芯片可以在超出**推荐工作条件**所示的应力下长期可靠地进行工作。

推荐工作条件

参数	最小值	最大值	单位
VDD	2	7	V
INx1、INx2	0	VDD	
单通道持续输出电流①	0	± 1.5	A
双通道持续输出电流①	0	± 1.2	
推荐工作环境温度	-25	85	°C

① 实际输出电流能力受实际功率耗散、封装热阻、PCB 布局以及内部过温保护影响。

电气特性

如无特殊说明， VDD=5V, Ta=25°C

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入电源						
I _{DD_SDBY}	输入电源待机电流	IN1=IN2="L" 或悬空, 无负载	-	-	1	uA
I _{VDDQ}	输入电源电流	IN1="H"或 IN2="H", 无负载	-	260	600	
输入逻辑特性						
V _{IN+}	INx1,2 输入逻辑信号 正向翻转阈值	INx1 或 INx2 上升	-	-	2.3	V
V _{IN-}	INx1,2 输入逻辑信号 负向翻转阈值	INx1 或 INx2 下降	0.5	-	-	

R_{PDN}	逻辑输入端下拉电阻	-	-	150	-	$K\Omega$
I_{IN+}	输入高电平时逻辑输入端电流	$V_{INx1,2}=3V$	-	20	-	μA
I_{IN-}	输入低电平时逻辑输入端电流	$V_{INx1,2}=0V$	-1	0	1	

驱动器特性

R_{ON}	功率管导通电阻，PMOS+N MOS	对角输出电流 $IO=\pm 100mA$	-	0.40	-	Ω
	功率管导通电阻，PMOS+N MOS	对角输出电流 $IO=\pm 800mA$	-	0.45	-	
V_{F_P}	PMOS 体二极管正向电压	$I_F=500mA$		0.8	-	V
	NMOS 体二极管正向电压	$I_F=-500mA$		0.75	-	

芯片过温度保护①

T_{SD}	过温度保护点	温度上升	-	150	-	$^{\circ}C$
$T_{HYS.}$	过温度保护迟滞温度	温度下降	-	30	-	

交流特性

t_{d_on}	输入到同相输出开通延迟时间	OUTx1 或 OUTx2 到地接 10Ω 负载， $50\%*V_{INx1}$ 或 V_{INx2} 上升沿 $\rightarrow 10\%*$ 负载电流 上升沿，另一输入保持接地	-	90	-	ns
t_{d_off}	输入到同相输出关闭延迟时间	OUTx1 或 OUTx2 到地接 10Ω 负载， $50\%*V_{INx1}$ 或 V_{INx2} 下降沿 $\rightarrow 90\%*$ 负载电流 下降沿，另一输入保持接地	-	70	-	
$t_{d_on_br}$	输入到另一相输出开通延迟	OUTx1 或 OUTx2 到地接 10Ω 负载， $50\%*V_{INx1}$ 或 V_{INx2} 下降沿 $\rightarrow 10\%*$ 负载电流 上升沿，另一输入保持接 VDD	-	360	-	
$t_{d_off_br}$	输入到另一相输出关闭延迟	OUTx1 或 OUTx2 到地接 10Ω 负载， $50\%*V_{INx1}$ 或 V_{INx2} 上升沿 $\rightarrow 10\%*$ 负载电流 下降沿，另一输入保持接 VDD	-	70	-	
t_r	输出电流上升时间	10 欧姆负载接地， $10\%*$ 负载电流 $\rightarrow 90\%*$ 负载电流		170	-	
t_f	输出电流下降时间	10 欧姆负载接地， $90\%*$ 负载电流 $\rightarrow 10\%*$ 负载电流		40	-	

① 仅由设计保证, 非 100% 产品量产测试。

功能描述

LY2501S 为一款专用于两个小型直流有刷或者单个步进电机控制的驱动芯片。该芯片采用双 H 桥电

路结构，内置 P/N MOSFET 功率开关，可为电机提供正转、反转、刹车以及待机四种控制模式。该芯片具有宽工作电压范围， $2V\sim7V$ 。在环境温度为 $27^{\circ}C$ ， $VDD=7V$ 的情况下，该芯片向电机负载提供持续电流高达 $1.5A$ (单通道)，最大峰值电流（或堵转电流）高达 $2.5A$ 。为了保证芯片安全工作，芯片内部集成了过温度保护。

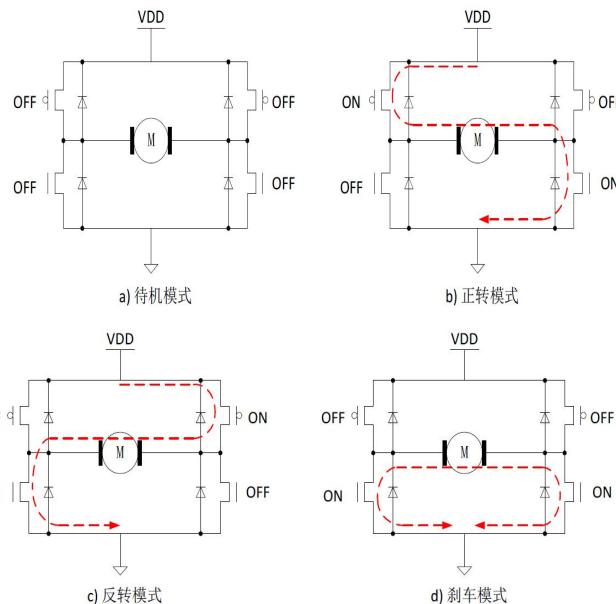
该芯片采用业界标准的 PWM 逻辑输入引脚 INA1/INA2, INB1/INB2。

输入逻辑控制

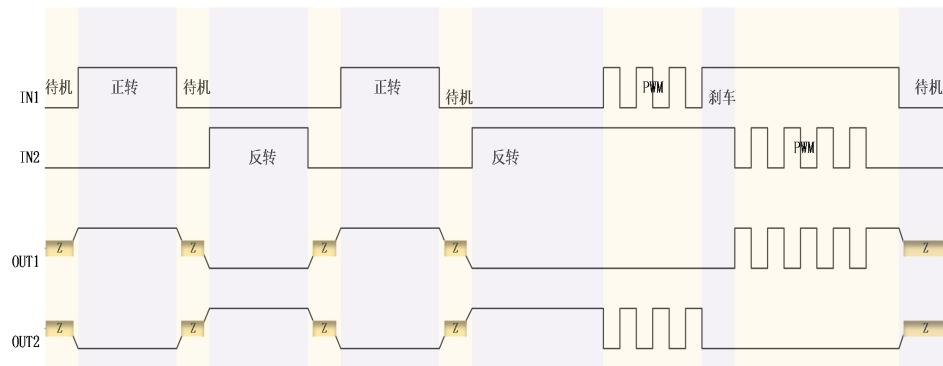
通过输入信号INx1和INx2可对电机进行如正转、反转、刹车以及待机四种模式控制。

控制真值表如下：

INx1	INx2	OUTx1	OUTx2	控制模式
0	0	Z	Z	待机(a)
1	0	1	0	正转(b)
0	1	0	1	反转(c)
1	1	0	0	刹车(d)



典型驱动波形:



防止功率管穿通电路

在全桥驱动电路中，同一半桥的高边PMOS 功率管和低边NMOS 功率管共同导通的状态称为功率管

穿通状态。功率管穿通会导致电源至地的瞬态大电流，该电流会引起额外的功耗损失，极端情况下会烧毁芯片。通过内置死区时间，可避免功率管穿通。典型的死区时间为100ns。

过温度保护

由于内部MOS的有限导通电阻，当芯片向负载提供电流时，芯片就会发热，结温度升高。该温度上升与功率管导通电阻、输出电流大小、环境温度以及电路板的布局有密切关系。芯片内部集成了感知结温度异常的过温度保护电路，能实时监控芯片温度异常并提供保护。当结温度超过150°C（典型值）时，芯片内部电路关闭功率管，停止输出电流，待结温度下降到130°C的安全温度后，芯片再重新恢复工作并按照输入对功率管进行开关控制。该过温度保护可避免芯片因过温而烧毁，同时可以避免因温度上升导致的封装塑料冒烟、起火等严重安全事故。

驱动器功耗

芯片内部驱动器功率MOSFET的导通电阻是影响芯片功耗的主要因素，其他静态电流产生的静态功耗被忽略不计。驱动器功耗的计算公式为：

$$P_D = I_M^2 * R_{ON} \quad ①$$

其中 I_M 表示流过电机负载电流， R_{ON} 表示H桥对角线功率MOSFET的总导通电阻。

注意：功率MOSFET的导通电阻随着温度的升高而升高，在计算驱动器的最大持续输出电流以及功耗时必须考虑导通电阻的温度特性。

驱动器最大持续功耗

该芯片内置过温保护电路，因此当驱动器耗散功率过大时，内部保护电路将进入热关断保护状态。在热关断保护状态下，马达将无法正常工作。驱动器最大持续功耗的计算公式为：

$$P_{D_MAX} = (150^\circ\text{C} - T_A) / \theta_{JA} \quad ②$$

其中150°C为芯片内部设定热关断保护温度点， T_A 为芯片工作的环境温度(°C)， θ_{JA} 为芯片的结到环境的热阻(单位°C/W)。

注意：驱动器的最大持续功耗与环境温度、封装形式以及散热设计等因素有关。

驱动器最大持续输出电流

根据驱动器功耗以及驱动器最大持续功耗可计算出驱动器的最大持续输出电流。根据①和②式，最大可持续电流计算公式为：

$$I_{M_MAX} = \sqrt{(150 - T_A) / (\theta_{JA} * R_{ON_T})} \quad ③$$

其中的 R_{ON_T} 为考虑温度特性后的功率MOSFET导通内阻。

注意：驱动器的最大持续输出电流与环境温度、封装形式、散热设计以及功率MOSFET的导通电阻等因素有关。

马达内阻选择



由于驱动器内部功率MOSFET有限的导通电阻，驱动器的最大持续输出电流有限。如果驱动器所驱动马达内阻极小，其堵转电流超过驱动器所能承受的最大持续输出电流太多，则很容易导致马达驱动电路进入过热保护状态，玩具车在跑动或者反复前进、后退时将出现抖动现象。在进行马达驱动芯片选型时，必须考虑马达的内阻。

应用指南

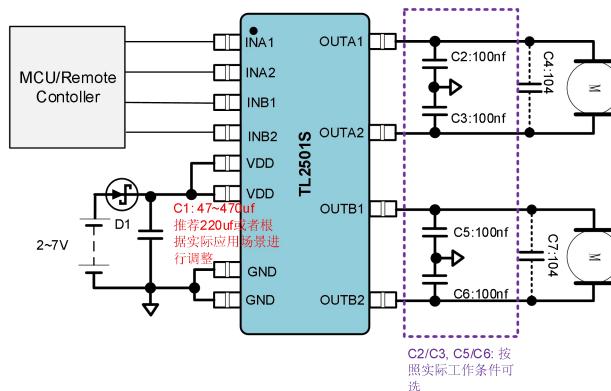


图1：典型遥控车玩具马达驱动电路

1、防止电池反接

将芯片的电源VDD与地线GND反接到电池的负极和正极，由于GND到VDD的二极管导通，将会有非常大的电流流过该两个引脚。很有可能会将导致芯片损坏，甚至导致封装塑料冒烟。为了防止电池反接的可能性，可在芯片的VDD和电池正极串联一个功率肖特基二极管。功率肖特基二极管的最大持续电流能力必须大于马达堵转的持续电流，否则肖特基二极管会因为过热而损坏。并且功率肖特基二极管的正向压降尽可能低，降低正向压降对可用电源电压的影响。另外，功率肖特基二极管的反向击穿电压必须大于最高电源电压，如果反向击穿电压过小，当电池反接时，会击穿肖特基二极管造成损坏。

2、芯片电源VDD对地去耦电容(C1)以及输出端电压尖峰处理

芯片电源VDD对地去耦电容C1(参考图1)主要有两个作用：1)、吸收马达线圈向电源释放的能量，稳定电源电压，避免电路因为过压而击穿；2)、在马达起动或者快速正转、反转切换的瞬间，马达需要瞬间大电流才能迅速启动。由于电池的响应速度以及连接引线较长，往往不能立即输出瞬态大电流，此时需要依赖靠近马达驱动电路附近的储能电容释放出瞬态大电流。根据电容的储能特性，电容容值越大，相同时间内的电压波动越小，因此在高压、大电流的应用条件下建议电容C1 取值大于100uF，建议根据具体的应用选择电容值，但是该电容C1 取值至少需要47uF。具体根据实际应用选择，电容的类型不限制，可以是瓷片电容也可以是电解电容。

特别注意事项：

1) 对于普通遥控车玩具，推荐C1为 $\geq 220\mu F$ 容值。当电源电压大于7V时，建议C1为 $\geq 470\mu F$ 。C1电容必须尽可能靠近芯片引脚。

2) 芯片输出端OUTx1和OUTx2分别到地的电容C2/C3和C5/C6，为输出电压尖峰抑制电容，推荐值为100nF。这些电容可有效防止因电机堵转后过热保护或者快速正反转切换导致的电压尖峰损坏输出端现象。可根据实际的工作条件去选择电容容值或者去留该电容。以上电容尽可能靠近芯片引脚。

3) 并联于OUTx1和OUTx2之间虚线连接的电容C4/C7表示为电机两端并联电容，不需要独立在PCB电路板上布置。

3、驱动器输出对地短路、输出端短（对角线短路）、电源短路

在正常工作时，驱动器H桥输出端与地线发生短路或者两个输出端相互短路或者对电源发生短路时，驱动器输出端会流过非常大的电流，产生极大的功耗，会触发芯片内部的过热保护电路并关闭驱动输出以保护芯片不烧毁。在电池电压比较高时，驱动器输出对地短路或者对电源短路时导致驱动器功率管处于高电压、大电流状态，此时驱动器消耗非常大的瞬态功耗。尽管驱动器功率管由于高功耗已产生危险

的高温，但由于器件的安全工作区限制以及硅材料具有的热阻特性限制，导致该高温无法快速扩散到过热保护电路的温度检测元件。因此过热保护电路无法及时关断驱动器输出而造成芯片烧毁。使用时应避免发生输出对地或者对电源短路的情况。测试时加入限流措施可避免发生此类损坏事件。

4、马达堵转

在正常工作模式情况下，如负载马达出现堵转并且堵转电流超过电路的最大持续电流，电路将进入过温保护模式以防止芯片损坏。但如果堵转电流远大于电路允许的最大峰值电流($>2.5A@VDD=7V$)，电路较容易损坏。LY2501S 应用于遥控玩具车前轮转向驱动时，只能应用在堵转电流小于 1.5A 的应用场合，如果超过 1.5A，LY2501S 容易进入过热保护状态，影响正常玩具操控。

5、峰值电流大大超过额定值

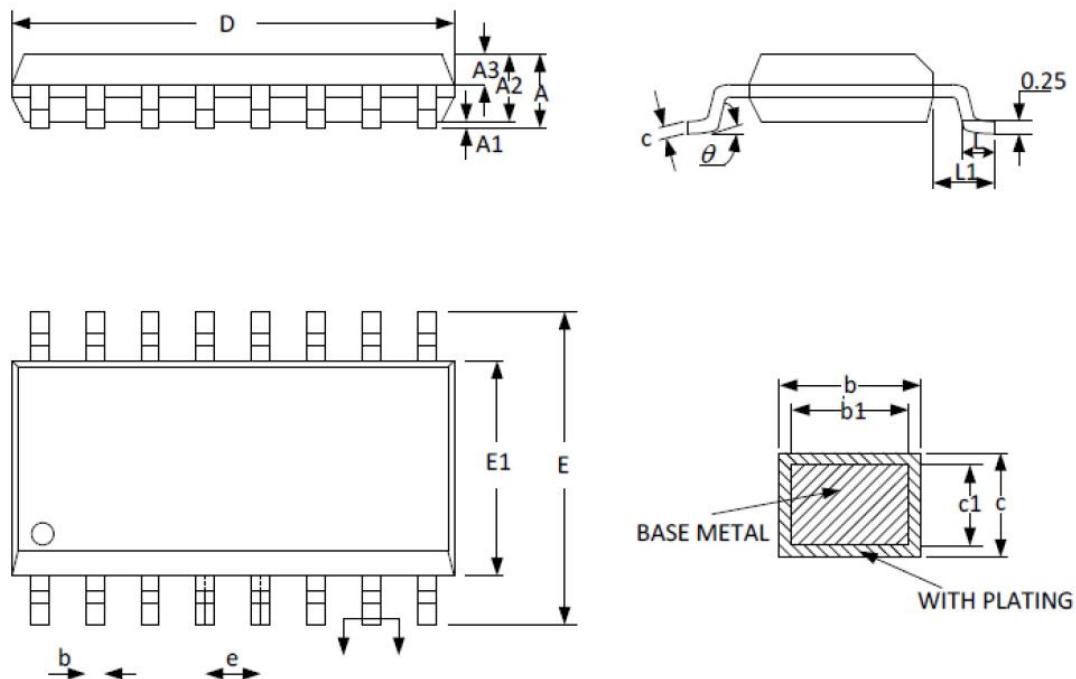
实际应用中如果马达的峰值电流大大超过芯片允许的最大峰值电流($>2.5A@VDD=7V$)，也会造成电路烧毁。

6、静电防护

电路的输入/输出端口采用了CMOS 器件设计，对静电放电敏感。虽然设计有静电防护电路，但在运输、包装、加工、储存过程中应该采取防静电措施，尤其是在生产过程中应重点考虑防静电。

封装信息

SOP_16L



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	-	-	1.77
A1	0.08	0.18	0.28
A2	1.20	1.40	1.60
A3	0.55	0.65	0.75
b	0.39	-	0.48
b1	0.38	0.41	0.43
c	0.21	-	0.26
c1	0.19	0.20	0.21
D	9.70	9.90	10.10
E	5.80	6.00	6.20
E1	3.70	3.90	4.10
e		1.27BSC	
L	0.5	0.65	0.80
L1		1.05BSC	
θ	0°	-	8°

版权声明

本公司保留未通知客户的情况下进行产品的修正、改善以及迭代，并更改该产品文档的权利。请在使用该产品前确定产品手册更新到最新版本。